

BEST AVAILABLE COPY

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number : 07-202064
 (43)Date of publication of application : 04.08.1995

(51)Int.CI. H01L 23/12

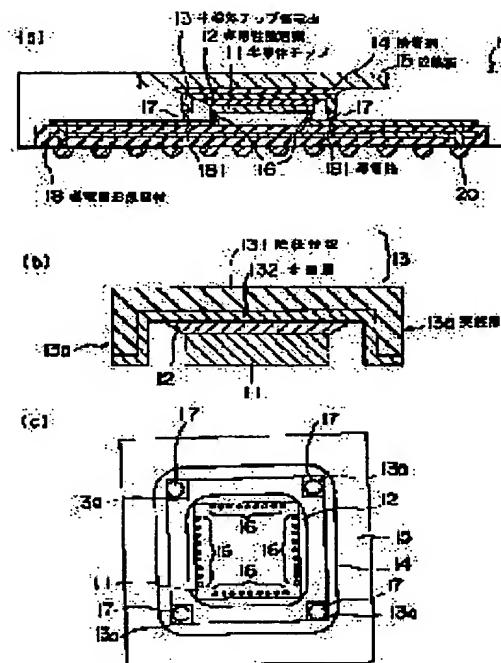
(21)Application number : 05-337420 (71)Applicant : TOSHIBA CORP
 (22)Date of filing : 28.12.1993 (72)Inventor : KOZONO HIROYUKI

(54) SEMICONDUCTOR DEVICE

(57)Abstract:

PURPOSE: To form a rear electrode for providing a substrate potential, keeping an excellent heat radiating property.

CONSTITUTION: The title semiconductor device contains a semiconductor chip 11, a semiconductor chip mounting board 13 with protrusions at the corners for mounting the semiconductor chip 11 by joining its rear by the aid of a conductive adhesive agent 12, a heat radiating board 15 which joins the semiconductor chip mounting board 13 by the aid of an adhesive agent 14, and a conductive path forming member 18 for connecting the semiconductor chip 11 and the semiconductor chip mounting board 13 through bumps 16 and 17. The semiconductor chip mounting board 13 is composed of an insulating board 131 and a metal layer 132 which coats a surface for the semiconductor chip 11 to be joined, and the protrusions 13a are formed so that their bottom surfaces may coincide with the surface of the semiconductor chip 11 in height, when the semiconductor chip 11 is joined.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination] 12.11.1998

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number] 3073644

[Date of registration] 02.06.2000

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開平7-202064

(43)公開日 平成7年(1995)8月4日

(51)Int.Cl.⁶
H 01 L 23/12

識別記号

府内整理番号

F I

技術表示箇所

H 01 L 23/12

L

J

審査請求 未請求 請求項の数6 OL (全4頁)

(21)出願番号 特願平5-337420

(22)出願日 平成5年(1993)12月28日

(71)出願人 000003078

株式会社東芝

神奈川県川崎市幸区坂川町72番地

(72)発明者 小國 浩由樹

神奈川県川崎市幸区小向東芝町1番地 株式会社東芝多摩川工場内

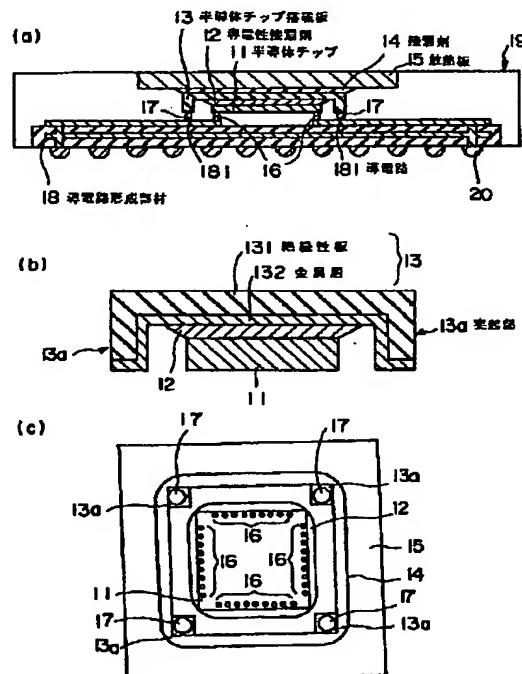
(74)代理人 弁理士 鈴江 武彦

(54)【発明の名称】 半導体装置

(57)【要約】

【目的】 良好的な放熱性を保ちつつ、基板電位を与える裏面電極を形成することを可能にした半導体装置を提供することである。

【構成】 半導体装置は半導体チップ11と、半導体チップ11の裏面を導電性接着剤12を介して接合しつつ角部に突起部13aを有する半導体チップ搭載板13と、半導体チップ搭載板13を接着剤14を介して接合する放熱板15と、バンプ16、17を介して半導体チップ11及び半導体搭載板13を接続する導電路形成部材18とを含む。半導体チップ搭載板13は、絶縁性板131と半導体チップ11を接合する側の面を被覆する金属層132とからなり、突起部13aは、半導体チップ11を接合した際に、突起部13aの底面と半導体チップ11の表面との高さが一致するように形成される。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 基板電位を与えるための裏面電極を有する半導体チップと、上記半導体チップの裏面を接合しつ少なくとも上記半導体チップと接合する第1の面が金属でありかつ上記第1の面の周辺部分に少なくとも突起部を有する半導体搭載部と、上記半導体搭載部の第2の面に接続される放熱板と、上記半導体チップ及び上記半導体搭載部と接続しつ表面及び内部に導電路を有する導電路形成部材とを具備する半導体装置。

【請求項2】 上記突起部の表面と上記半導体チップの表面とは同じ高さに位置することを特徴とする請求項1記載の半導体装置。

【請求項3】 上記突起部と上記半導体チップに設けられたパッド電極は、それぞれバンプを介して上記導電路に接続されることを特徴とする請求項1記載の半導体装置。

【請求項4】 上記半導体搭載部は、セラミック系の絶縁性板と上記半導体チップと対向する面を被覆する金属層からなることを特徴とする請求項1記載の半導体装置。

【請求項5】 上記半導体搭載部と上記放熱板とは一体成形され、かつ放熱性の高い金属からなることを特徴とする請求項1記載の半導体装置。

【請求項6】 上記半導体搭載部と上記放熱板とは一体成形され、かつセラミック系の絶縁性板と上記半導体チップと対向する面を被覆する金属層からなることを特徴とする請求項1記載の半導体装置。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【産業上の利用分野】 本発明は半導体装置に関し、特に基板電位を与えるための裏面電極を有する半導体チップを搭載する半導体装置に関するものである。

【0002】

【従来の技術】 半導体チップから発生する熱を放熱するには、半導体チップの裏面から熱を外部に伝達することが効率のよい方法である。ところで、半導体基板に特定の電位を与えていたりする場合、半導体チップの裏面に裏面電極を設けることが望ましいことも知られている。しかしながら、裏面を用いて、放熱を行うことと裏面電極を形成することとを同時にすることは困難である。

【0003】 以下、従来の構造を図4を参照して説明する。半導体装置は、半導体チップ101と、該半導体チップ101の裏面にバッファー102を介して接合された半導体チップ搭載板103と、半導体チップ101の表面をバンプ104を介して接合された導電路形成部材105と、それらを封止する封止樹脂106とからなる。導電路形成部材105は、半導体チップ101と対向する側の面(表面)及び内部に導電路107が形成されており、裏面にはそれら導電路107と各々接続される外部端子用バンプ108が設けられている。バッファー

—102は弾力がありかつ熱伝導率の高い材料により形成されている。

【0004】 このような構造であると、半導体チップ101から発生する熱はバッファー102及び半導体チップ搭載板103から放散され、高放熱を実現するのに有利な構造である。しかし、本構造では、半導体チップ101に裏面電極を形成することは不可能である。そのため、半導体基板に特定の電位を与えるためには、裏面電極を形成することが望ましいが、本構造では裏面に形成すべき電極を表面に形成している。従って、チップサイズを増大させることになると共に、半導体チップ101のプロセス上半導体基板に負担となっている。

【0005】

【発明が解決しようとする課題】 本発明は、良好な放熱性を保ちつつ、基板電位を与える裏面電極を形成することを可能にした半導体装置を提供することを目的とする。

【0006】

【課題を解決するための手段】 本発明による半導体装置は、裏面に裏面電極を有する半導体チップと、上記半導体チップの裏面を接合しつ少なくとも上記半導体チップと接合する第1の面が金属でありかつ上記第1の面の周辺部分に少なくとも突起部を有する半導体搭載部と、上記半導体搭載部の第2の面を接続する放熱板と、上記半導体チップ及び上記半導体搭載部と接続しつ表面及び内部に導電路を有する導電路形成部材とを含み、上記突起部の表面と上記半導体チップの表面とは水平な位置である。また、上記突起物は上記半導体搭載部の周辺部分に配置され、例えば4隅に形成される。

【0007】

【作用】 上記半導体装置によれば、上記半導体チップの裏面は上記半導体搭載部の上記金属部分に接合されており、上記裏面電極は上記半導体搭載部の上記突起部において上記導電路形成部材と接続する。また、半導体チップからの熱は上記半導体搭載部を介して上記放熱板より放散される。従って、半導体チップの裏面に裏面電極を形成することができると共にその裏面より熱を放散することができる。

【0008】

【実施例】 以下、本発明の一実施例を図面を参照して説明する。本発明による第1の実施例を図1より説明する。同図(a)によれば、半導体装置は、半導体チップ11と、半導体チップ11の裏面を導電性接着剤12を介して接合しつ周辺部、例えば角部に突起部13a(同図(b))を有する半導体チップ搭載板13と、半導体チップ搭載板13を接着剤14を介して接合する放熱板15と、半導体チップ11表面の図示しないパッド電極上に形成されたバンプ16及び半導体チップ搭載板13の突起部13a上に形成されたバンプ17と、それらバンプ16、17を介して半導体チップ11及び半導

体搭載板13と接続する導電路形成部材18と、半導体チップ11を封止する封止樹脂19とからなる。導電路形成部材18は、半導体チップ11と対向する側の面(表面)とその内部に導電路181が形成されており、裏面には導電路181にそれぞれ接続する外部端子用バンプ20が形成されている。半導体チップ11及び半導体搭載板13の突起部13aは、それぞれバンプ16、17を介して導電路181に接続される。

【0009】次に、同図(b)を参照して、半導体チップ搭載板13を詳細を説明する。半導体チップ搭載板13は、絶縁性板131と半導体チップ11を接合する側の面を被覆する金属層132とからなり、半導体チップ11と接合される側の周辺部分は凸状の突起部13aが設けられた構造である。絶縁性板131として、熱伝導率が高く絶縁性の高いセラミックが用いられている。突起部13aは、半導体チップ11を接合した際に、突起部13aの底面と半導体チップ11の表面との高さが一致するように形成される。突起部13aの高さは、半導体チップ11の厚さ+接着剤14の厚さに相当する。

【0010】同図(c)によれば、半導体チップ11は半導体チップ搭載板13の中央に導電性接着剤12により接合され、半導体チップ搭載板13は放熱板に接着剤14により接合される。半導体チップ搭載板13の突起部13a上及び半導体チップ11の上記パッド電極上に、バンプ16、17が同一の高さに形成される。

【0011】また、本半導体装置を形成において、図3に示すような状態、バンプ16、17が形成された状態で、放熱板15側を導電路形成部材18に押し付けてバンプ16、17をそれぞれ導電路181に接続させていく。それゆえ、突起部13aの高さを上述のように規定することにより、半導体チップ11を押し潰したりすることなく、容易に導電路形成部材18と接続することができる。

【0012】このような構造の半導体装置であると、半導体チップ11の裏面に裏面電極を形成することができる。その裏面電極は金属層132と接続し、バンプ17及び電導路181を介して外部端子用バンプ20に電気的に接続される。また、半導体チップ11から発生する熱は、半導体チップ搭載板13を介して放熱板15より放散される。半導体チップ搭載板13の絶縁性板131はセラミックであり、放熱板15はCu等からなるため、放熱性がよい。

【0013】更に、外部に放熱フィンを取り付ける場合でも、フィンを電気的に中立とすることが可能となり、ひいては集積回路の高周波での動作特性を向上されることが可能である。

【0014】次に、本発明による第2の実施例を図2を参照して説明する。但し、第1の実施例と異なるところのみを説明する。本実施例における半導体チップ搭載部21は、第1の実施例における半導体チップ搭載板13

と放熱板15とに相当する。半導体チップ搭載部21は、放熱性に優れたCuW、Cu等の金属から作成されており、その周辺部には突起部21aが形成されている。半導体チップ11は導電性接着剤12を介して半導体チップ搭載板21に接合される。同図(b)に示すように、突起部21a上にはバンプ17、半導体チップ11のパッド電極上にはバンプ16が形成される。

【0015】更に、本発明による第3の実施例を図3を参照して説明する。但し、第1の実施例と異なるところのみを説明する。本実施例における半導体チップ搭載部31は、第1の実施例における半導体チップ搭載板13と同様に、セラミック系の絶縁性板311と、半導体チップ11と接合する面を被覆する金属層312とからなり、周辺部に突起部31aが設けられている。本構造の半導体装置であると、半導体チップ11から発生する熱は半導体チップ搭載部31から放散され、半導体チップ11の裏面電極は金属層312、バンプ17及び電導路181を介して外部端子用バンプ20に接続される。尚、各実施例における突起部は、4隅に設けた例であるが、突起部は任意の位置の設けることができるというまでもない。

【0016】
【発明の効果】本発明によれば、半導体チップの裏面に裏面電極を形成することと裏面からの放熱とを同時にを行うことができる。裏面電極を形成することにより、チップサイズの小型化につながる。また、裏面電極を含め半導体チップに形成された電極を導電路形成部材にバンプを介して接続することができ、高密度実装を図ることができる。

【図面の簡単な説明】
【図1】本発明による第1の実施例を模式的に示す断面図(a)と、(a)中の半導体チップ搭載板部分を拡大した断面図(b)と、(a)を半導体チップ表面方向からみた部分平面図(c)である。

【図2】本発明による第2の実施例を模式的に示す断面図(a)と、(a)を半導体チップ表面方向からみた部分平面図(b)である。

【図3】本発明による第3の実施例を模式的に示す断面図である。

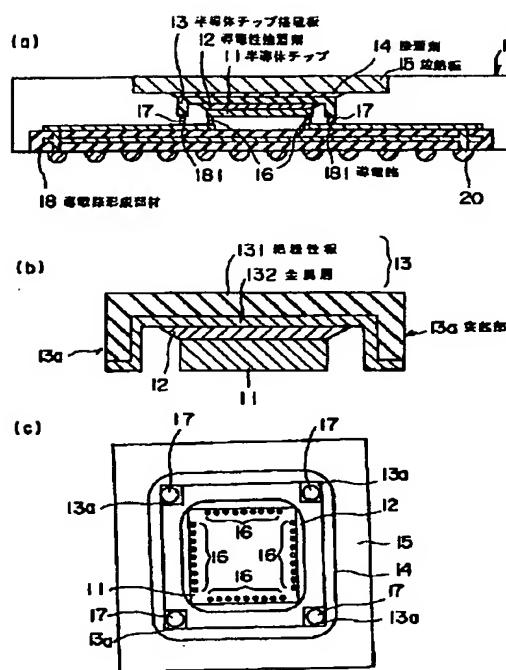
【図4】従来における半導体装置を示す断面図である。
【符号の説明】
11…半導体チップ、12…導電性接着剤、13…半導体チップ搭載板
13a…突起部、131…絶縁性板、132…金属層
14…接着剤、15…放熱板、16、17…バンプ
18…導電路形成部材、181…導電路
19…封止樹脂、20…外部端子用バンプ
21…半導体チップ搭載部、21a…突起部
31…半導体チップ搭載部、31a…突起部
311…絶縁性板、332…金属層

BEST AVAILABLE COPY

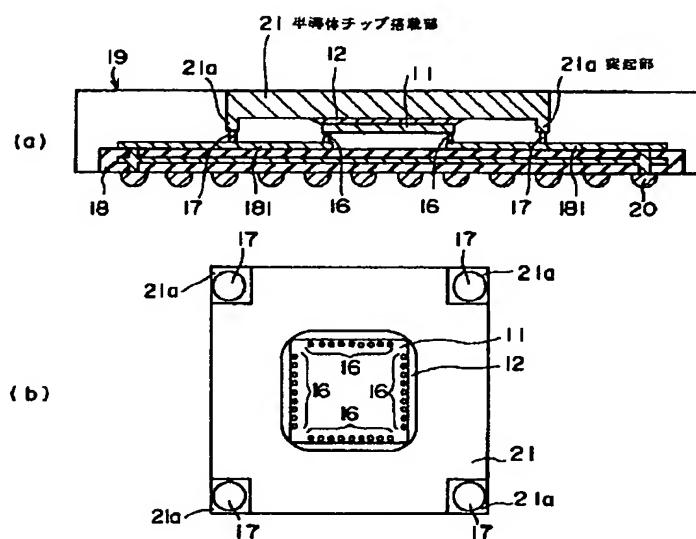
(4)

特開平7-202064

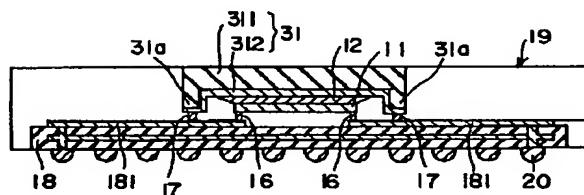
【図1】



【図2】



【図3】



【図4】

